

24 КВАНТОВОЕ КИНЕТИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ
В ВЫСОКОЧАСТОТНОМ ПОЛЕ

В.И.Мельников

Обычный вывод кинетического уравнения [1] основан на разделении воздействия на электрон внешнего поля и столкновений с рассеивателями. Считается, что электрон между столкновениями движется под действием поля как классическая частица с законом дисперсии, определяемым зонной структурой полупроводника, а вероятность рассеяния электрона не зависит от поля. Соответственно этому, кинетическое уравнение имеет вид

$$\frac{\partial f}{\partial t} + eE \frac{\partial f}{\partial p} - \int \frac{d^3 p'}{(2\pi)^3} \left[W(p', p) f(p') - W(p, p') f(p) \right], \quad (1)$$

где правая часть содержит столкновительный член, а левая – силовой. $f(p)$ – функция распределения электронов по импульсам, E – электрическое поле, в общем случае зависящее от времени, e – заряд электрона, $W(p', p)$ – вероятность перехода из состояния p' в состояние p . $W(p', p)$ в общем случае есть сумма членов вида

$$|M(p', p)|^2 \delta[\epsilon(p') - \epsilon(p) \pm \epsilon_{p', p}], \quad (2)$$

где $M(p', p)$ – матричный элемент оператора взаимодействия электрона с рассеивателем, $\epsilon(p)$ – энергия электрона, $\epsilon_{p', p}$ – энергия, теряемая или приобретаемая электроном при рассеянии.

Целью настоящей работы является вывод квантового кинетического уравнения для электронов в однородном высокочастотном поле $E(t) = E_0 \cos \omega t$ в условиях сравнимости кванта энергии поля $\hbar \omega$ и средней энергии электрона $\bar{\epsilon}$.

Вывод проведем на примере электронов с квадратичным законом дисперсии. Вводя электрическое поле через вектор-потенциал $A(t) =$

$$= -\frac{E_0 c}{\omega} \sin \omega t, \text{ где } c \text{ – скорость света, и решая уравнение Шредингера}$$

$$(\hbar = 1)$$

$$i \frac{\partial \psi}{\partial t} = \epsilon(p, t) \psi; \epsilon(p, t) = \frac{\left[p - \frac{e}{c} A(t) \right]^2}{2m}, \quad (3)$$

получим волновую функцию электрона в поле

$$\psi_p(r, t) = \exp \left\{ i p r - i \int_0^t \epsilon(p, t') dt' \right\}. \quad (4)$$

В условиях $\omega_r \gg 1$ (r — время свободного пробега) канонический импульс p является хорошим квантовым числом, так как он меняется только за счет столкновений. Естественно поэтому писать кинетическое уравнение для функции распределения электронов по каноническому импульсу $F(p)$ (мы обозначаем одной буквой канонический и кинематический импульсы, так как достаточно разных обозначений для соответствующих функций распределения).

Амплитуда рассеяния из состояния $\psi_{p'}(r, t)$ в состояние $\psi_p(r, t)$ определяется интегралом

$$\int \psi_{p'}^*(r, t) H_{ln} \psi_p(r, t) dr dt. \quad (5)$$

Видно, что включение однородного электрического поля в $\psi_p(r, t)$ не изменяет результата интегрирования по координатам. Интеграл по времени, приводивший ранее к закону сохранения энергии вида $\delta[\epsilon(p') - \epsilon(p) - \epsilon_{p', p}]$ теперь изменится:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ -i \int_0^t [\epsilon(p', t') - \epsilon(p, t') \pm \epsilon_{p', p}] dt' \right\} dt = \\ & - \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} i \ell I_\ell \left(\frac{e E_0 (p' - p)}{m \omega^2} \right) \delta[\epsilon(p') - \epsilon(p) \pm \epsilon_{p', p} + \ell \omega]. \end{aligned} \quad (6)$$

При получении уравнения (6) использовано соотношение $\exp[i x \cos \omega t] = - \sum_{\ell} i^\ell I_\ell(x) \exp(i \ell \omega t)$, где $I_\ell(x)$ — функция Бесселя.

Из формулы (6) следует, что квантовое кинетическое уравнение получается из уравнения (1) вычеркиванием слагаемого с высокочастотным полем в левой части (1) (так как высокочастотное поле полностью учтено в интеграле столкновений) и заменой выражений вида (2) на

$$|M(p', p)|^2 \sum_{\ell} I_\ell^2 \left(\frac{e E_0 (p' - p)}{m \omega^2} \right) \delta[\epsilon(p') - \epsilon(p) \pm \epsilon_{p', p} + \ell \omega]. \quad (7)$$

Выпишем конкретный вид квантового кинетического уравнения для случая рассеяния электронов на фононах

$$\begin{aligned} 0 = 2\pi^2 g^2 \left(\frac{d^3 k}{(2\pi)^3} \right) |m_k|^2 \sum_{\ell} I_\ell^2 \left(\frac{e E_0 k}{m \omega^2} \right) & \left[(1 + N_k) \delta(\epsilon_p - \epsilon_{p+k} + \omega_k + \ell \omega) + \right. \\ & \left. + N_k \delta(\epsilon_p - \epsilon_{p+k} - \omega_k + \ell \omega) \right] F(p+k) - \end{aligned}$$

$$- [(1 + N_k) \delta(\epsilon_p - \epsilon_{p+k} - \omega_k + \ell\omega) + N_k \delta(\epsilon_p - \epsilon_{p+k} + \omega_k + \ell\omega)] F(p) \Big]. \quad (8)$$

Обозначения те же, что и в [2]. В левую часть формулы (8) может быть обычным образом записано $(\partial F/\partial t) + eE_1(\partial F/\partial p)$, если E_1 – слабо переменное поле. Как следует из выражения (8), квантовое кинетическое уравнение явным образом учитывает возможность "многофотонного" поглощения или излучения электрического поля электронами полупроводника.

Уже упоминалось, что критериемгодности уравнения (8) является $\omega_r \gg 1$. Строго этот критерий может быть получен при выводе формулы (8) с использованием систематической методики, предложенной в [2]. Предельный переход в уравнении (8) при $\omega \ll \epsilon_p$ дает уравнение, совпадающее с тем, которое получается после перехода в классическом кинетическом уравнении вида (1) к каноническому импульсу с последующим усреднением по времени $\omega_r \gg 1$.

При слабых полях в формуле (8) следует заменить I_0 на 1, вместо $I_1(x)$ подставить $x/2$, а остальные члены суммы отбросить, так как при малых x функция Бесселя $I_\ell(x) \sim 1/\ell! \cdot (x/2)^\ell$. Если аргумент функции Бесселя порядка единицы, важны все члены ряда. Оценка величины поля дает в этом случае $E_0 \sim e^{-1}(m\hbar)^{1/2} \omega^{3/2}$. Если принять $m \sim 0.05 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$, $\omega \sim 2 \cdot 10^{14} \text{ с}^{-1}$ (лазер на CO₂), то $E_0 \sim 3 \cdot 10^5 \text{ в/сек}$, что хотя и велико, но реально достижимо.

Из уравнения (8), в частности, следует, что влияние высокочастотного поля на упругое рассеяние электрона (член с $\ell = 0$) приводит к изменению проводимости полупроводника при облучении светом [3].

Постановка рассмотренной задачи принадлежит В.М.Буймистрову. Автор признателен В.М.Буймистрову, З.С.Грибникову и Э.И.Рашба за обсуждение результатов.

Институт теоретической физики
им. Л.Д.Ландау
Академии наук СССР

Поступило в редакцию
2 января 1969 г.

Литература

- [1] А.И.Ансельм. Введение в теорию полупроводников. М., Физматгиз, 1962, гл. 7.
- [2] Л.В.Келдыш. ЖЭТФ, 47, 1515, 1964.
- [3] В.М.Буймистров. Письма в ЖЭТФ, 8, 274, 1968.